

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ВІДГУК ПОЛОЖЕННЯ КРАЮ  
ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ОПТИЧНОГО ПОДЛІННЯ  
ХАЛЬКОГЕНІДНИХ СТЕКОВ  $\text{Ge}_x\text{As}_{1-x}\text{Se}_{1-y}$ , ЯК ОСНОВА  
ДЛЯ СТВОРЕННЯ СЕНСОРІВ ТЕМПЕРАТУРИ

М.В. Шпотюк<sup>1</sup>, Д.О. Чалій<sup>2</sup>, С.Б. Убізький<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Національний університет „Львівська політехніка”, Львів, Україна  
<sup>2</sup> Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Львів,  
Україна

Халькогенідним склям (ХС) припіняється значна увага дослідників ще з часу відкриття їх напівпровідниковых властивостей у 1950-х рр. Шоправда, не зважаючи на очікування, використання ХС в електроніці ще обмежене через неможливість легування об'ємних зразків (типові вони володіють  $p$ -типом провідності, а рівень Фермі у них знаходиться чиже посередині забороненої зони). Натомість ці матеріали успішно використовують в оптоелектроніці та фотоніці як активні середовини для пристрій різного призначення. У даній роботі нами представлена можливість використання ХС у якості активних середовин для сенсорів температури.

Для досліджень було вибрано зразки ХС  $\text{Ge}_x\text{As}_{1-x}\text{Se}_{1-y}$  у широкому хімічному складі ( $0.07 \leq x \leq 0.30$ ). Такий вибір зумовлено тим, що саме ці системи  $\text{Ge}-\text{As}-\text{Se}$  в останні роки знаходять широке застосування в сучасних ІІ оптиці та фотоніці. Цей склад є особливо популярним у широкому ринку, як, наприклад, AMFIR («*amfir.com.ua*») чи GALTIC («*galtic.com.ua*»), які є продуктами компанії *Amorphous Materials Inc.* та *AMFIRE IR Glasses*, відповідно. При цьому розріз  $\text{Ge}_x\text{As}_{1-x}\text{Se}_{1-y}$  з обмеженою кількістю, оскільки вздовж цієї лінії існує можливість отримати ХС з розрізаною тоноюючию за рахунок зміни лінією параметрів.

Ці були приготовані стандартним методом оподілження розрізаною лінією чистотою не менше 99,999 %. Синтез проводився у вакуумі до залізникового пінку  $10^{-4}$  Torr квадратні ампули. Оскільки зразки відхилювалися протягом кількох годин при температурі біля 250-300 °C, то температуру розміщення їх було підвищено під час виготовлення розрізаної лінії.

Температурну залежність оптичного пропускання ХС у сферичніх лініях залежності оптичного подлення досліджували в широкому діапазоні температур («*Avantes 2048*» (Avantes, Голландія)). Для фіксації